

DESCRIPTION

MPS8097 is NPN silicon planar epitaxial transistor designed for general purpose applications.

TO-92A



EBC

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6V
Collector Current	I_C	200mA
Continuous Power Dissipation	P_d	350mW
Operating & Storage Junction Temperature	T_j, T_{stg}	-55 to +150°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT	TEST CONDITIONS
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	40		V	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=0^*$
Collector-Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	40		V	$I_C=100\mu\text{A}$ $I_E=0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	6		V	$I_E=10\mu\text{A}$ $I_C=0$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}		30	nA	$V_{CE}=40\text{V}$ $I_B=0$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}		10	μA	$V_{CB}=60\text{V}$ $I_E=0$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}		20	nA	$V_{EB}=6\text{V}$ $I_C=0$



MICRO ELECTRONICS LTD.

38, Hung To Road, Microtron Building, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Kwun Tong P.O. Box 69477 Hong Kong. Fax No. 2341 0321 Telex: 43510 Micro Hx. Tel: 2343 0181-5

Oct-96

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT	TEST CONDITIONS
D.C. Current Gain	H_{FE}	250	700		$I_C=0.1\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(\text{sat})}$		0.4	V	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=5\text{mA}^*$
			0.3	V	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Voltage	V_{BE}		0.65	V	$I_C=0.1\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$
Current Gain-Bandwidth Product	f_T	250		MHz	$I_C=10\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{ob}		4	pF	$V_{CB}=5\text{V}$ $I_E=0$ $f=1\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ib}		10	pF	$V_{EB}=0.5\text{V}$ $I_C=0$ $f=1\text{MHz}$

* Pulse Test : Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$, Duty Cycle = 2%.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9